情報通信関連 ハードウエア分野

> ソフトウエア 販売サービス 関連分野

NAITO DENSEI KOGYO CO.,LTD NDK Network 設計·評価事業部 評価部 事業案内

バイス評価

電子デバイス 関連分野

デバイス製造

デバイス設計

内藤電誠工業株式会社 デバイスカンパニー

総合技術力で要求に応じたソリューションを提供

ダイナミックソリューション技術体制 フレキシブルな納期対応 お客様に満足して頂けるコスト提供



信頼性試験

- 1 耐熱性試験/耐湿性試験
- 2 ハイパワー恒温恒湿試験
- 3 300℃タイプ温度サイクル試験
- 4 蒸気加圧試験
- 5 温度サイクル試験
- 6 導体抵抗モニタシステム
- 7 リフロー耐熱性試験
- 8 熱抵抗測定
- 9 染色試験 (Dye & Pry)
- 10 リボール

多種多様な試験設備で お客様のニーズにお応えします。

品質マネジメントシステム IS09001 環境マネジメントシステム IS014001

> 各種試験 実施

試験内容 提案



試験データ

分析



各手法によるデータ分析

統計的手法を用いた寿命推定 活性化エネルギーの算出などの データ分析

耐候性試験

- 耐熱性試験…… 1 2 6耐湿性試験…… 1 2 6
- ●温度サイクル試験…… 3 5 6
- ●プレッシャークッカー試験… ④
- ●その他各種試験

その他試験

- 各種測定試験実装評価試験 ···············7)
- 熱抵抗試験·······
- 染色試験······9
- その他···················

報告書 作成



分かりやすい報告書

加速係数の算出などの データ分析、 報告書の作成

情報収集



専門スタッフによるコーディネイト

お客様のニーズに合った試験計画の提案

- MIL規格
- ·JIS規格
- · JEITA規格等

幅広い分野の技術相談

試料、目的など 情報収集・分析



1 耐熱性試験/耐湿性試験

- ●耐熱性試験・耐湿性試験は高温環境下、または低温環境下における 部品及び材料の温度負荷(低温側-70°C~高温側+260°C)を与え、 高温・低温に対する耐久性・信頼性の評価を行います。
- ●試験を行いながら製品温度測定や抵抗のモニタリング、試験前後の 写真撮影や寸法測定など、製品・材料に求められる機能や特性を 考慮した試験が可能です。



恒温槽 (260°CMax)



恒温恒湿槽 (-70°C~+150°C、30%~98%)

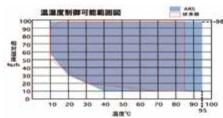
2 ハイパワー恒温恒湿試験

New

●より厳しさを求められる環境試験 (車載用部品、モバイル製品など) の試験要求にお応えします。 弊社ではハイパワー恒温恒湿試験機を導入し、幅広い温湿度環境下での耐性試験に対応可能です。







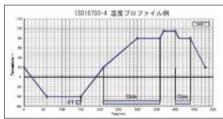
1. 幅広い温湿度制御範囲 低温側-75℃、高温側+180℃、 湿度10~98%rhの温湿度制 御範囲を実現可能です。

3. 処理量拡大を実現した大型槽

内容量1100Lにより大型試料も試験可能です。

⇒テストエリア:

W1100mm×H1000mm×D1000mm



2. 優れた温度上昇・下降性能

試料負荷50kgで約3°C/分の 温度サイクル試験 (-75°C~+ 180°C) が可能です。

3 300℃タイプ温度サイクル試験







●次世代パワー半導体向け300℃仕様冷熱衝撃試験 次世代パワー半導体は大電流による高温域での使用 が想定されており現状試験機の限界温度+200℃を 超える温度での耐熱性が求められます。

幅広い温度制御範囲

低温側:-70°C~0°C、高温側:+300°C~+60°C ⇒従来機(Max+200°C)

高温度域の拡大制御が可能です。

4 蒸気加圧試験

●蒸気加圧試験は不飽和加圧蒸気試験 (HAST) と飽和加圧蒸気試験 (PCT) が可能です。 不飽和加圧蒸気試験 (HAST) は主に電子部品に行われる試験で電子部品に温度と湿度 をかけ、更に圧力を加える試験です。飽和加圧蒸気試験 (PCT) は飽和水蒸気での試験 で不飽和加圧蒸気 (HAST) 以上に厳しい条件下での試験です。

本試験は、温度環境100℃以上且つ水蒸気圧力を部品及び材料に加える事で水分侵入を短時間で試験実施できます。



蒸気加圧試験槽 (+105℃~+140℃、75~100%)

温度サイクル試験

●外部環境あるいは自己発熱による繰り返し熱応力のストレスに対する試験として、 温度サイクル試験があります。これは部品及び材料に低温、高温の繰り返し温度変化 を与え耐性をみる試験です。

温度サイクル試験は熱の媒体として気体を用いています。温度サイクルの試験条件は、 一般的に部品及び材料の保存温度上限と下限に繰り返しさらすこととなっています。 加速性を高めるために保存温度の上限、下限を越えた試験条件を決める場合がありま すが、実使用上の加速性が得られない場合があり、注意する必要があります。



温度サイクル試験槽 $(-70^{\circ}C\sim +200^{\circ}CMAX)$

導体抵抗モニタシステム

●半導体部品などの接合部に発生する微小クラック等を抵抗値 の変化により判定する事が可能です。各種耐候性試験設備と 連動して試験を実施することにより、試験効率を向上すること ができます。本システムは独自のマルチスキャン方式と国際 標準対応の計測器を搭載しており、MAX120ch、4端子測定 法に (10-3~10-6Ω) に対応しています。



導体抵抗変化図 計測結果表示例

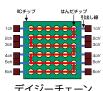
基板設計・実装~試験・解析まで一貫サポート

●BGAPKGの半田ボール接合信頼性評価 例

▶ 導体抵抗試験事例



温度サイクル試験槽と 導体抵抗モニタシステム



デイジーチェーン サンプルの配線 例



BGA クラックによる不良発生 例



非破壊解析 X線観察 SAT観察

※実装は内藤電誠 町田製作所 (甲府) にて実施



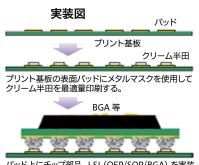
半田印刷機 SPPV



高速搭載機 MSR



リフロー炉 NXII-745PC



パッド上にチップ部品、LSI (QFP/SOP/BGA) を実装。



ピーク温度に加熱し、印刷したクリーム半田を溶解し

リフロー耐熱性試験

●高密度実装に対応する表面実装デバイス (SMD) の樹脂パッケージの薄型化が進み、基板実装のリフロー工程による 加熱でパッケージクラック等が発生し、信頼性に影響を与える問題が起きています。

断面研磨

染色試験

▶試験事例

●リフロー耐熱性試験の前処理として、代表規格で定められた 「BAKE (乾燥) SOAK (吸湿)~REFLOW (リフロー)」までの 試験を行います。また、吸湿レベルの事前確認として、試験前 後で超音波探査映像装置 (SAT) を使用して観察を実施し、 パッケージクラック、内部剥離観察等を行うことが可能です。



半導体デバイスの 吸湿した水分を脱湿

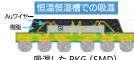


半導体デバイスの 吸湿耐性水準に合わせ吸湿



指定された温度条件にて リフローを必要回数実施

▶ 不具合イメージ例: PBGA



吸湿した PKG (SMD) ●PKG 内に浸透した水分イメ-

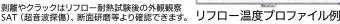
リフローにより急激に加熱

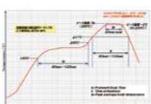


PKG の水分が膨張 PKG 内での膨張した水分イメ・



膨張により剥離及びクラック等発生 : PKG 内での剥離のイメージ





冷却 3 Zone (加熱max使用時冷却 2 Zone) (遠赤外線併用熱風対流加熱タイプ) ●各種Pbフリー・フラットピーク加熱等の 各種リフロー条件に対応。

逆バイアス発熱法 (製品サンプルで測定可能) 熱抵抗測定

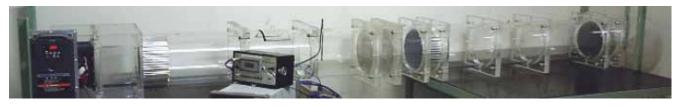


●熱抵抗とは:温度の伝えにくさを表す値で、発熱量あたりの温度上昇量を表したもの 半導体パッケージを基板に組み込む際の判断材料として適用していただけます。



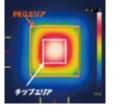
熱抵抗測定システム: TRM-7110A (当社開発システム) 基板作製から熱抵抗測定まで、一貫したサポートを提供 発熱検証、基板設計、実装、熱抵抗測定まで 全てサポートする事ができます。

測定項目	θj-a (ジャンクション・周囲温度間熱抵抗) ψj-t (ジャンクション・PKG top間熱パラメーター) ジャンクション温度=チップ温度
測定環境	風洞:JEDEC規格準拠 (JEDEC51-2、51-6) 周囲温度:常温 風速:0~4m/sec
測定サンプル	ダイオード温度特性のとれるPKG 発熱実験を行い測定可能か検証をいたします
加熱用出力電源	最大出力電流:2A 最大出力電圧:5V
測定ch数	2ch
測定に必要な情報	パッケージ外形図 ピン端子表 チップ内ブロック図 (発熱エリアを検証するため)

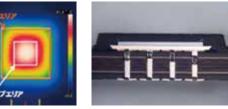


▶ オプション:各種解析対応可能

【メリット】●熱抵抗実測結果の解析 測定した熱抵抗が妥当な値であるかを解析できます。



サーモグラフィー解析 構造解析

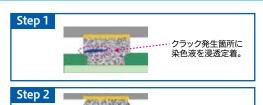


染色試験(Dye&Pry)

●BGAボールなどのはんだ接合ク ラックや完全破断が一目で判断 できます。

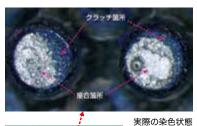
引き剥がし状態にもよりますが、 PKG全体の接合部観察が可能に なります。

断面研磨と併用することにより、 クラックの深さなども知ることが できます。





染色状況を確認



染色引き剥がし後 基板側イメージ図

10) リボール

●実装基板から取り外したサンプルの ボールを再生します。



BGA リボール

サンブルベーク(脱水)

ベーク (脱水) し、はんだ除去、 膨れ、クラック等を防止します。

基板から PKG を

引き剥がす。

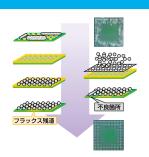
残はんだ除去

再搭載のボールが均一になる様、 余分なはんだを取り除きます。

はんだボール付け

フラックス塗布されたランド上に ボール搭載を行います。

完 了



総合技術力で要求に応じたソリューションを提供

ダイナミックソリューション技術体制 = フレキシブルな納期対応 お客様に満足して頂けるコスト提供

調査解析

- 1 外観解析
- 2 電気的特性解析
- 3マイクロフォーカスX線解析
- 4 マルチフォーカスX線CT解析
- 5 超音波探傷 (SAT) 解析
- 6 PKG開封内部解析
- 7 LED内部解析
- 8)ドライエッチング(RIE)
- 9 断面/平面解析

高度な技術力、先端設備による ワンストップソリューション。

品質マネジメントシステム IS09001 環境マネジメントシステム IS014001 調査箇所の 解析·分析

現象の 確認·調査

解析項目の 提案



長年の経験による知見

事実に基づいた 解析・分析結果から 長年培った知識による考察

専門スタッフによる コーディネイト

お客様のニーズに合った 解析方法の提案

幅広い分野の技術相談

背景•経緯 試料・目的 外観解析

- リード変形、変色 ………1
- PKGクラック、欠損 ……

非破壊解析

- ■電気的特性測定………2 ■ X線透過観察 ………34
- ●超音波解析 · · · · · · · 5

半破壊解析

- PKG開封(表、裏) ············
- ●ドライエッチング………8

破壊解析

解析•分析

結果の

考察

- 断面/平面解析……
- ●微細配線の切断、加工 …… 9

● 成分分析 · · · · · · 9

報告書 作成





分かりやすい報告書 原因の推定

対策の提案

信頼性試験〜解析まで

一貫体制

情報収集

調 查 解 析《外観解析·非破壊解析》

1 外観解析

●外観観察は、不具合発生状況を概ね把握するために行います。 実体・光学顕微鏡などを用い、良品と相違がないかをあらゆる方向より観察します。 クラック、ボイド、ピンホール、機械的損傷、異物付着、汚染、変色、腐食などより故障モードを推察し解析手法及び 進め方を検討していきます。







ピン間 (ショート)

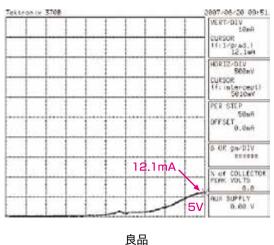
はんだ酸化状態

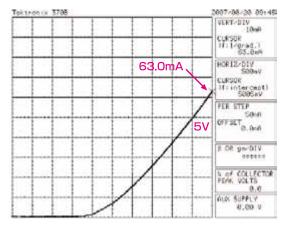
基板配線間異物

2 電気的特性解析

●故障発生から時間が経過しているサンプルは、故障症状に変化がないか電気的に特性測定を行います。 電子部品は、マルチメータ等により出力電圧値・電流値・抵抗値などを測定し確認します。 半導体は主に、プログラマブルカーブトレーサを用い、VDD-GND間のV-I特性を測定しショート、リーク、 オープン等故障モードを推察します。

VDD-GND端子間に5Vを印加しV-I特性を調査した結果、良品が12.1mA流れているのに対し、不良品では63.0mAと約5倍流れていることを確認しました。





不良品

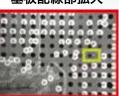
マイクロフォーカスX線解析

●0.4 µm焦点の高解像・高コントラストで、通常のX線観察では見えない超微細な接合状態や 断線・短絡の観察。高密度実装基板やBGA・CSPのボイドやハンダ形状などの究極の観察を実現。

PBGA 品



基板配線部拡大



基板 TH

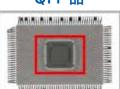


基板 TH 拡大



X線源:160kV/0.3mA 分解能:0.4μm

QFP 品



ワイヤー部拡大



ワイヤー曲り確認



1stBd 部拡大



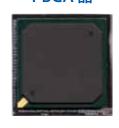
2ndBd 部拡大

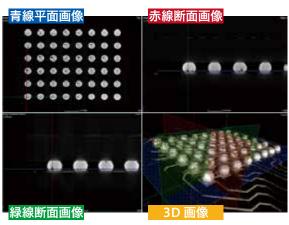


4 マルチフォーカスX線CT解析 New

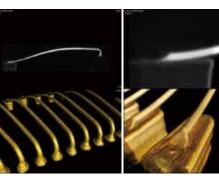
●マルチフォーカスX線管、フラットパネルディテクタ搭載により、高出力、高解像での観察が実現。 ハイパワーモードにより従来透過しにくい材質においても観察可能。 また、CT機能により、はんだ接合等3次元立体像(3D観察)、各断層(スライス観察)も可能。

PBGA 品





LSI ボンディングワイヤー (2D/3D)



スマートフォン(コネクタ不良の観察例)

X 線透過観察



スマートフォン内の基板に 実装されているコネクタ

クリッピングツールによる 3D 像の仮想切断像



コネクタ端子周囲の一部を仮想切断して、 着目するコネクタ端子を確認。

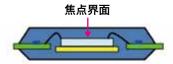


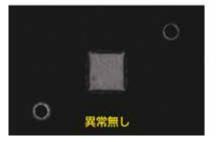
X線源:160kV/1mA 分解能: < 0.5 μ m

5 超音波探傷 (SAT) 解析

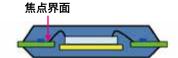
●半導体・電子部品の界面剥離・ボイド・クラックを超音波 (反射波) を用いて非破壊解析を行います。 リフロー実装時のパッケージ耐熱性評価後の界面剥離の確認に威力を発揮します。 プローブも5種類保有しており、多種パッケージに対応可能です。(プローブ: 25、50、75、140、230MHz)

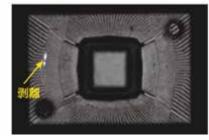
▶ QFP SAT観察事例





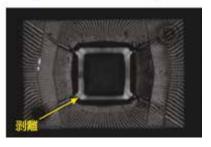
樹脂-チップ表面界面





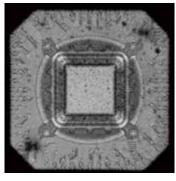
樹脂-インナーリード表面界面



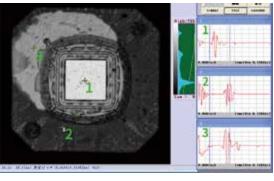


樹脂 - ダイパッド表面界面

▶ PBGA SAT観察事例



PBGA リフロー耐熱性試験前



PBGA リフロー耐熱性試験後

界面剥離箇所は、ポイント3のように 概ねコントラストが明るく(白く) なります。

界面剥離の判定は、画像コントラストの相違、反射波形の相対比較により行います。

左記PBGAでは、ポイント2(正常)とポイント3(剥離)の反射波の相対比較結果により、ポイント3が2の波形全体と位相が逆転している状態より剥離と判定します。



高分解能

低ノイズ高ゲインの高周波帯230MHzの超音波探傷器を搭載ができ、その他多種のプローブにより様々なパッケージの観察が可能です。

高解像度

最小走査ピッチ 0.5μ mの高精度スキャナによる高精細な測定が可能です。

JEDEC規格 (J-STD-035) 対応

C-SAM画像(カラー表示画像)、A-Scan画像(波形画像)を電子データファイルとして撮る事ができます。

計測機能

欠陥部分 (剥離、ポイド) の寸法及び面積比率を計測する事ができます。

■仕様

- ●走査範囲:340×340×50mm
- ●最大倍率:1000倍
- ●最小ピッチ: 0.5 μm 256表示階調
- ●プローブ種類: 25、50、75、140、230MHz



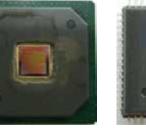
6 パッケージ開封内部解析

●パッケージ開封は、事前にX線にて内部構造を把握した上、内部のチップやワイヤを傷めず開封を行います。解析目的、サンプルサイズ、構造、種類に応じて、開封エリアの大きさを選択します。 また特殊開封は、基板実装品の一部品のみ開封し、開封後、機能特性の確認を行う際に有効です。 開封後は、光学顕微鏡、走査電子顕微鏡 (SEM) などを用いて詳細に内部観察を行います。

▶ 開封事例 (BGA、QFP)

チップ領域のみを開封

ボンディングワイヤ領域まで開封

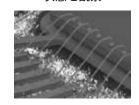


チップ表面観察等を 目的とした開封例



チップ〜ワイヤ状態の観察等を 目的とした開封例

ボンディングワイヤ全体の 状態を観察

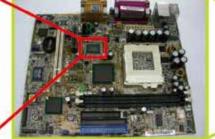






▶ 特殊開封事例(基板実装品)





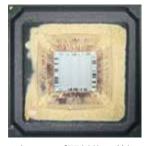


基板に実装したままの状態で開封し、基板や他の部品にダメージを与えずに開封を実施します。

▶ 特殊開封事例 (Cuワイヤ)

●Cuワイヤにダメージなく薬液のみでの開封が可能です。

(※Cuワイヤ品の開封は、事前に条件出しが必要です。)



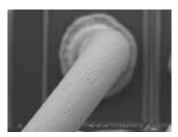
パッケージ開封後の外観



従来: Cu ワイヤの腐食



Cu ワイヤ全体像

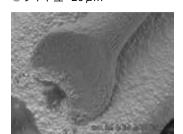


1st 側: Cu ワイヤ腐食なし



【PKG 情報】

- PKG 種類: 484 ピン BGA
- ●PKG サイズ: 23×23mm t2mm
- チップサイズ: 7.5×7mmワイヤ径: 20 μm



2nd 側: Cu ワイヤ腐食なし

LED内部解析 (開封内部解析·断面研磨解析)

●LEDはゲル状シリコン樹脂で封入され開封が難しいが、電気的特性が測定できる状態で開封が可能です。



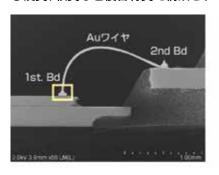


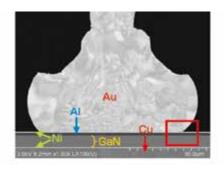


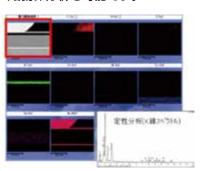
内部観察



●硬質、軟質など複合材質で構成されている接合箇所において、フラットな断面加工、観察、分析も可能です。

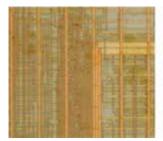






ドライエッチング (RIE)

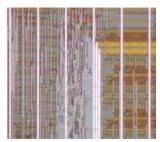
●パッケージ開封後、ドライエッチング装置でチップ表面のポリイミド膜を除去します。 さらに酸化膜~Ti系のバリアメタルまでエッチングも可能です。



ポリイミド膜あり



ポリイミド膜除去後

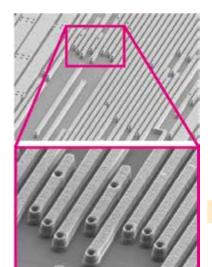


SiO2~Ti 系バリアメタルまで エッチング後



ES373 (NSC 製)

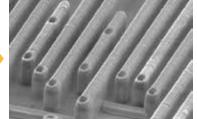
●高周波出力: 20~100W ●選択ガス:CF4/02 ■ステージ寸法:50mmφ ●ステージ温度:30~50℃



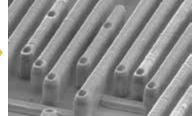
優れた異方性のドライエッチングにより、 多層配線の構造を観察。



等方性エッチングの イメージ



最上層配線観察



上 2 層配線観察



上 3 層配線観察

調査解析《破壊解析》

断面/平面解析

●BGA・FCなどはんだバンプの接合、基板へのはんだ実装で発生するはんだ内のボイド、熱的ストレスの影響による クラック等の状態確認のため、断面解析を行います。また複合材質構造、脆弱材質などについては、アルゴンイオン ビームを用いたクロスセクションポリッシャ(CP)、フラットミリングにて断面加工を行います。

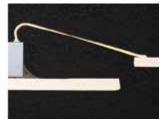
その後、超高分解電界放出型走査電子顕微鏡 (FE-SEM)、走査電子顕微鏡 (SEM) を用い詳細な観察を行います。

> 実装部品 断面解析事例









BGA アウターボール

チップコンデンサ

SOP アウターリード

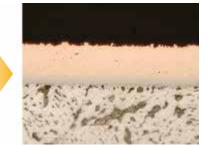
Bd ワイヤ



BGA 断面観察箇所

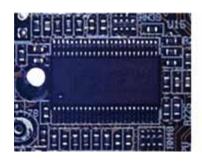


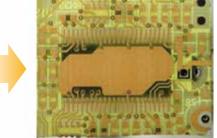
はんだボール接合状態



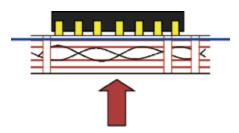
はんだ-BGA 電極接合状態

▶ プリント基板 平面解析事例



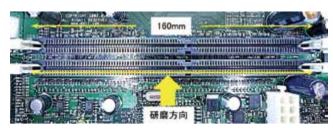


基板 1 層目配線パターン



基板裏面から1層目まで研磨

コネクタ部品 断面解析事例

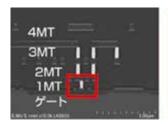




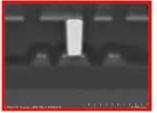
はんだ実装状態観察(代表5端子)

▶ LSIチップ 断面解析事例

LSI 回路配線断面



加速電圧 5.0KV 倍率 ×10.0K Pt 蒸着あり



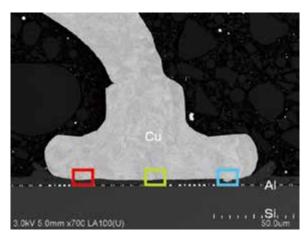
加速電圧 5.0KV 倍率 ×50.0K Pt 蒸着あり

加速電圧 3.0KV 倍率 ×1.00K Pt 蒸着あり

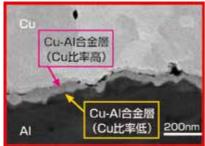


加速電圧 5.0KV 倍率 ×20.0K Pt 蒸着あり

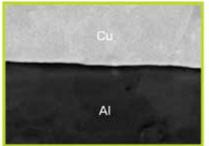
▶ Cuワイヤボンディング 断面 (FE-SEM) 観察事例



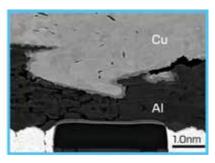
- ・断面研磨⇒フラットミリング加工
- ・FE-SEM (SU8000) にて、Cuボンディング接合状態、合金層形成 状態の観察が可能です。
- ・Cuワイヤのボンディングは、一般的にAuワイヤよりボンディング加重が高く設定されます。
- ・下記のSEM画像は、AIパッドの損傷状態を観察した事例です。



合金層間クラック

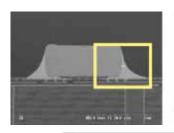


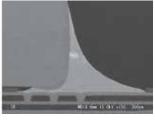
合金層形成不良

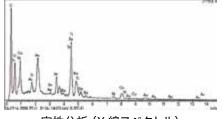


AI パッド損傷

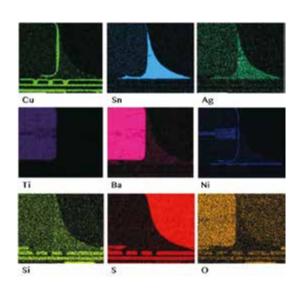
▶ セラミックコンデンサ 分析事例







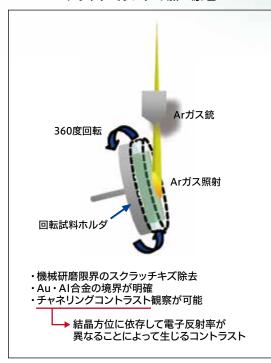
定性分析 (X 線スペクトル)



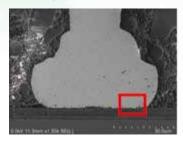
9 断面/平面解析

▶ フラットミリング加工・観察事例

フラットミリングの加工原理



機械研磨後 Au ボンディング部 FE-SEM 写真



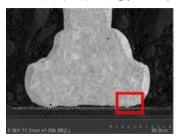


フラッ<mark>トミリン</mark>グ実施

加工条件

加速電圧: 5kV ビーム入射角: 4° 時間: 20min

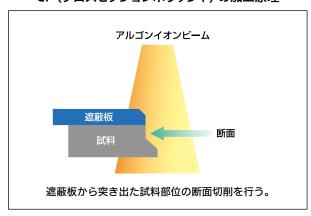
フラットミリング後 Au ボンディング部 FE-SEM 写真





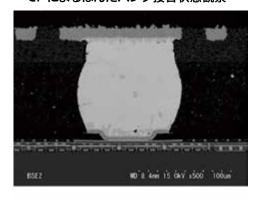
▶ CP (クロスセクションポリッシャ) 加工・観察事例

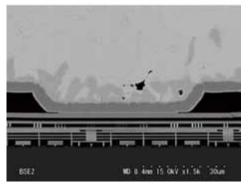
CP (クロスセクションポリッシャ) の加工原理



CPは、試料に遮蔽板を密着させ、遮蔽板から突き出した部分をArイオンビームで切削し断面を作製する方法です。 CP法で用いるArイオンは2~6kVと低エネルギーであり、試料が複合材料であっても選択エッチングが起こりにくく、イオンダメージの少ない平滑な断面が得られます。

CP によるはんだバンプ接合状態観察





内藤電誠グループは、デバイスソリューション事業を中心に

産業機器ソリューション事業やDMS事業、ソフトウェア事業などを展開する5社によって、

構成される総合エレクトロニクスカンパニーです。

私たちは、優れた技術、豊富なノウハウをベースに、グループの総合力を駆使し、 お客さまのニーズに応えることができるよう、新たな価値の創造を目指して、取り組んでいます。

■企業理念

私たちは人にあたたかい はつらつカンパニー。 人と地球の未来のために新たな価値を創造します。

■内藤電誠グループ概要

立/1950年2月 創 代表 者/代表取締役 佐藤 暁 社 員 数/980名(2015年3月末現在) 事業内容/デバイスソリューション事業、

産業機器ソリューション事業、 MCUソリューション事業、 環境エネルギーソリューション事業、 DMS事業、 ソフトウェア事業、 販売事業

■内藤電誠グループ



■グループ企業

デバイスソリューション

内藤電誠工業株式会社

*内藤電誠グループの本部機構
・LSIの製造、受託組立・LSIの設計開発・半導体デバイス等の信頼性評価、解析

社:〒211-0011 神奈川県川崎市中原区下沼部1933 Tel.044-431-7121 Fax.044-431-7131 本 溝 の 口 工 場:〒213-0011 神奈川県川崎市高津区久本3-9-25 Tel.044-811-5421 Fax.044-811-1052 羽 茂 工 場:〒952-0504 新潟県佐渡市羽茂本郷1939 Tel.0259-88-3141 Fax.0259-88-2330

九州日誠電氣株式会社

業務内容 LSIの製造受託

本 社 / 工 場:〒861-3546 熊本県上益城郡山都町南田295 Tel.0967-72-3611 Fax.0967-72-3511

内藤電誠工業/羽茂工場









産業機器ソリューション/MCUソリューション/環境エネルギーソリューション/DMS事業

株式会社内藤電誠町田製作所

・マイコン周辺装置の設計、製造 ・OEM、受託設計システム開発 ・高密度SMT基板、MCMの製造 ・IT関連製品の製造、検査、リペア ・液晶モニターの開発、製造

本社/金森工場:〒194-0012 東京都町田市金森4-12-5 Tel.042-796-8611 Fax.042-796-4254 甲 府 エ 場:〒400-0314 山梨県南アルプス市下市之瀬1220-1 Tel.055-284-5181 Fax.055-284-6361

ソフトウェア事業/販売事業

デンセイシリウス株式会社

社:〒213-0011 神奈川県川崎市高津区久本3-9-25 Tel.044-822-7781 Fax.044-811-7790 名古屋事業所:〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-4-27稲恒ビル栄3F Tel.052-265-8613 Fax.052-265-8614 北 陸 事 業 所: 〒920-0064 石川県金沢市南新保町八34-1 Tel.076-237-0992 Fax.076-237-0993

佐 渡 営 業 所:〒952-0312 新潟県佐渡市吉岡1688 Tel.0259-55-4101 Fax.0259-55-4103





内藤電誠工業株式会社 デバイスカンパニー

設計・評価事業部 評価部 (溝の口工場)

〒213-0011 神奈川県川崎市高津区久本3-9-25 Tel: 044-811-5496 Fax: 044-850-5851

E-mail: ndkz-hyouka@ndk-reliability-lab.com URL: http://www.ndk-reliability-lab.com





